

**关键指标**

- 频率: 8~10.5GHz
- 增益: 17dB
- 噪声系数: 2.4dB
- 1dB 压缩点输出功率: 15.5dBm
- 电压/电流: +5V/60mA
- 芯片尺寸: 1.95mm×1.05mm×0.1mm

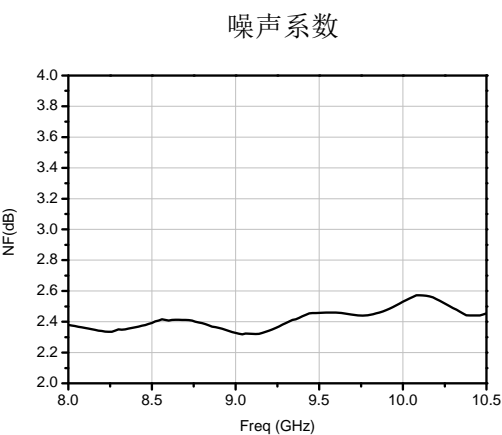
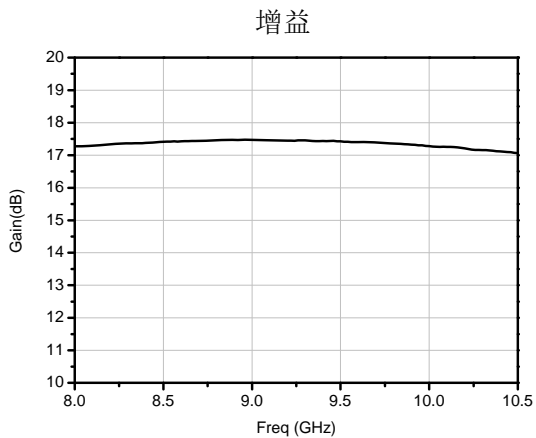
**产品简介**

HG115FP-1 是一款 8~10.5GHz 低噪声放大器芯片, 增益为 17dB, 噪声系数为 2.4dB, 1dB 压缩点输出功率为 15.5dBm。

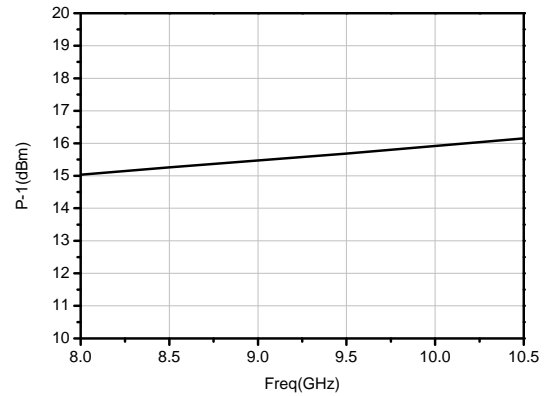
**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~10.5		
增益(dB)	—	17	—
增益平坦度(dB)	—	±0.25	—
输入驻波	—	1.4	—
输出驻波	—	1.6	—
噪声系数(dB)	—	2.4	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	15.5	—
静态电流 (mA)	—	60	—

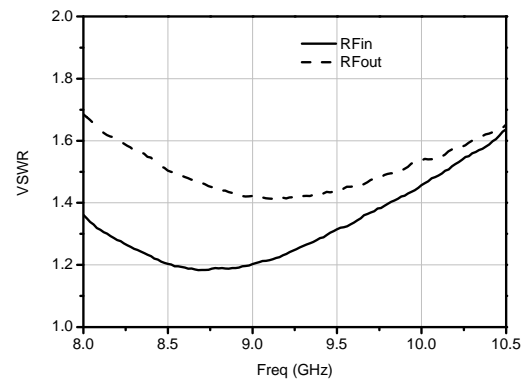
**典型测试曲线**



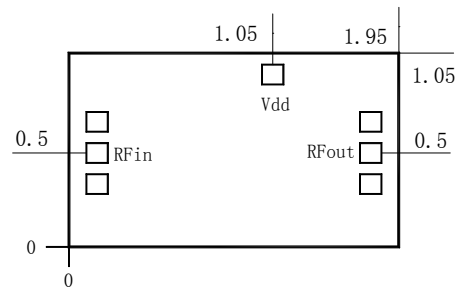
**1dB 压缩点输出功率**



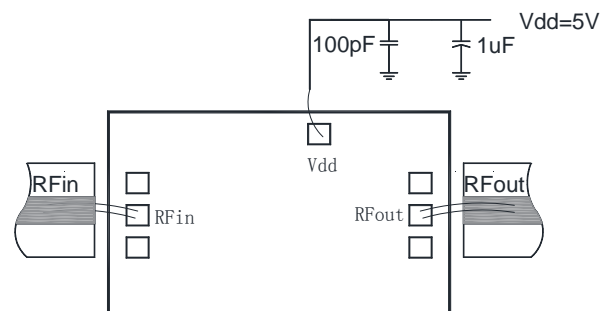
**驻波**



**外形和端口尺寸 (um)**



**推荐装配图**



### 绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。